*САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ*

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

## Пояснительная записка

**Тема**: УСТРОЙСТВО СЕЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ

СЕМИСЕГМЕНТНОГО ИНДЕКАТОРА

**КП 2201 453К**

Преподаватель **Швайка** **О. Г.**

Учащийся Бляхман Е.С.

 УТВЕРЖДЕНО

 предметной комиссией

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2004г.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# З А Д А Н И Е

на курсовое проектирование по курсу ЭЦВМ и МП

учащемуся Бляхман Е.С. IV курса 453-К группы

 СПИШЭ техникума

 (наименование среднего специального учебного заведения)

 (фамилия, имя, отчество)

Тема задания Устройство селективного управления работой семисегментного индикатора

Курсовой проект на указанную тему выполняется учащимися техникума в следующем объеме:

1. Пояснительная записка.

 Введение.

 1. Общая часть.

* 1. Назначение устройства управления.

1.2. Составление таблицы истинности работы устройства.

1.3. Минимизация логической функции.

1.4. Выбор и обоснование функциональной схемы устройства.

1.5. Синтез электрической принципиальной схемы в базисе И-НЕ.

1.6. Выбор элементной базы проектируемого устройства.

1.7. Описание используемых в схеме ИМС и семисегментного индикатора.

2. Расчетная часть проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Ориентировочный расчет быстродействия и потребляемой мощности устройства

управления.

* 1. Расчет вероятности безотказной работы устройства управления и среднего

времени наработки на отказ.

4. Графическая часть проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Схема электрическая принципиальная.

Устройство селективного управления работой семисегментного индикатора.

 Заключение.

 Список литературы.

 Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Срок окончания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зав. отделением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Преподаватель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВВЕДЕНИЕ**

Развитие микроэлектроники способствовало появлению малогабаритных, высоконадежных и экономичных вычислительных устройств на основе цифровых микросхем. Требования увеличения быстродействия и уменьшения мощности потребления вычислительных средств привело к созданию серий цифровых микросхем. Серия представляет собой комплект микросхем, имеющие единое конструктивно – технологическое исполнение. Наиболее широкое распространение в современной аппаратуре получили серии микросхем ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ и схемы на МОП – структурах.

ТТЛ схемы появились как результат развития схем ДТЛ в результате замены матрицы диодов многоэмиттерным транзистором. Этот транзистор представляет собой интегральный элемент, объединяющий свойства диодных логических схем и транзисторного усилителя.

**1. Общая часть.**

**1.1. Назначение устройства**

 X1

 X2

 X3

 X4

 Y1

 Y2

 Y3

 Y4

 Y5

 Y6

 Y7

2

4

3

1

7

5

6

На рисунке в виде “черного ящика” показана комбинационная схема (КС) управляющая семисегментным индикатором. На вход схемы подаются различные комбинации двух сигналов X1, X2, X3, X4 (X1- старший). На индикатор предполагается выводить лишь отдельные цифры из множества шестнадцатеричных цифр. На выходе Y должна быть единица, если соединенный с этим выходом сегмент должен загореться при отображении цифр (для логической схемы). Требуется:

**1**. Составить совмещенную таблицу истинности, комплект карт Карно для функции Y, провести совместную минимизацию в СДНФ и записать логические формулы, выражающие Y через X, выполнить преобразование этих формул к виду, обеспечивающему минимально возможную реализацию КС в системе логических элементов ТТЛ серии типа К155 или К555;

**2**. Выполнить принципиальную электрическую схему устройства, провести расчет быстродействия и мощности;

**3**. Выполнить расчет надежности.

**1.2. Составление таблицы истинности работы устройства.**

Создание таблицы истинности работы устройствапо следующему набору комбинаций **1, 2, 3, 4, 7, 8, B, C, F.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

**1.3. Минимизация логической функции.**

**Составить СДНФ по таблице, построить карты Карно и минимизировать их**.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **1** |  | **1** |
|  | **1** |  |  |  |
|  | **1** | **1** |  |  |
|  | **1** |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  | **1** | **1** | **1** |  |
|  | **1** |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **1** |  | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  | **1** |  | **1** | **1** |
|  | **1** |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1** | **1** |
|  | **1** |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  | **1** |  |  | **1** |
|  | **1** |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **1** |  | **1** |
|  | **1** |  |  |  |
|  | **1** | **1** |  | **1** |
|  |  |  |  |  |

**1.4. Выбор и обоснование функциональной схемы устройства.**

&

&

&

&

&

**Y1**

1

&

&

&

**Y2**

1

&

&

&

**Y4**

1

&

&

&

&

**Y3**

1

&

&

&

**Y5**

1

&

&

&

**Y6**

&

&

&

&

&

**Y7**

1

1

На основе карт Карно составлена следующая функциональная схема.

1.5. Синтез электрической принципиальной схемы

**в базисе «И-НЕ».**

Можно уменьшить количество наименований схем. Это можно сделать путем преобразования с помощью формул:

В результате получаем только схемы “И-НЕ” и схемы отрицания

**Повторяющиеся значения формул СДНФ**

**1.6. Выбор и обоснование элементной базы.**

Для проектирования было предложено выбрать элементы ТТЛ серий 155 и 555. После сравнения характеристик этих двух серий мною была выбрана 555 серия.

Потому что:

* во-первых, коэффициент разветвления у неё в два раза больше, чем у 155 серии, что в дальнейшем даст возможность не использовать дополнительные резисторы на входе схемы
* во-вторых, элементы 555 серии потребляют меньше мощности в отличие от серии 155, так как их максимальное напряжение и сила тока меньше, чем у 155 серии.

В 555 серию входят различные логические элементы общим числом 98 наименований. Их назначение заключается в построении узлов ЭВМ и устройств дискретной автоматики с высоким быстродействием и малой потребляемой мощностью.

Элементы И – НЕ в 555 серии содержат простые n-p-n транзисторы VT2 – VT4, многоэмиттерный транзистор VT1, а так же резисторы и диоды, количество которых зависит от конкретного элемента. Такая схема обеспечивает возможность работы на большую емкостную нагрузку при высоком быстродействии и помехоустойчивости.

В качестве индикатора выбран семисегментный индикатор АЛС320Б, один из немногих индикаторов способный отображать не только цифровую информацию, но и буквенную, что необходимо в проектируемом устройстве.

В моей схеме используется следующие микросхемы серии К555:

К555ЛА1, К555ЛА2, К555ЛА4, К555ЛН1, К555ЛН2

**1.7. Описание используемых в схеме ИМС и семисегментного индикатора.**

**К555ЛА1**

**Два логических элемента 4И-НЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №выв. | Назначение | №выв. | Назначение |
| 1234567 | Вход Х1Вход Х2СвободныйВход Х3Вход Х4Выход Y1Общий | 891011121314 | Выход Y2Вход Х5Вход Х6СвободныйВход Х7Вход Х8Ucc |

&

&

1

2

4

5

9

10

12

13

8

6

**DIP14**

**Пластик**



|  |  |
| --- | --- |
| Тип микросхемы | К555ЛА1 |
| Фирма производитель | СНГ |
| Функциональные особенности | 2 элемента 4И-НЕ |
| Uпит | 5В ± 5% |
| Uпит (низкого ур-ня) | ≤ 0,5В |
| Uпит (высокого ур-ня) | ≥ 2,7В |
| Iпотреб (низкий ур-нь Uвых) | ≤ 2,2мА |
| Iпотреб (высокий ур-нь Uвых) | ≤ 0,8мА |
| Iвых (низкого ур-ня) | ≤ |-0.36|мА |
| Iвых (высокого ур-ня) | ≤ 0,02мА |
| P | 7,88мВт |
| tзадержки | 20нСек |
| Kразвёртки | 20 |
| Корпус | DIP14 |

**К555ЛА2**

**Логический элемент 8И-НЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №выв. | Назначение | №выв. | Назначение |
| 1234567 | Вход Х1Вход Х2Вход Х3Вход Х4Вход Х5Вход Х6Общий | 891011121314 | Выход Y1СвободныйСвободныйВход Х7Вход Х8СвободныйUcc |

1

&

2

3

4

8

6

5

11

12

**DIP14**

**Пластик**



|  |  |
| --- | --- |
| Тип микросхемы | К555ЛА2 |
| Фирма производитель | СНГ |
| Функциональные особенности | элемент 8И-НЕ |
| Uпит | 5В ± 5% |
| Uпит (низкого ур-ня) | ≤ 0,5В |
| Uпит (высокого ур-ня) | ≥ 2,7В |
| Iпотреб (низкий ур-нь Uвых) | ≤ 1,1мА |
| Iпотреб (высокий ур-нь Uвых) | ≤ 0,5мА |
| Iвых (низкого ур-ня) | ≤ |-0,4|мА |
| Iвых (высокого ур-ня) | ≤ 0,02мА |
| P | 4,2мВт |
| tзадержки | 35нСек |
| Kразвёртки | 20 |
| Корпус | DIP14 |

**К555ЛА4**

**Три логических элемента 3И-НЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №выв. | Назначение | №выв. | Назначение |
| 1234567 | Вход Х1Вход Х2Вход Х4Вход Х5Вход Х6Выход Y2Общий | 891011121314 | Выход Y3Вход Х7Вход Х8Вход Х9Выход Y1Вход Х3Ucc |

&

1

2

13

4

6

11

12

5

8

&

&

10

9

3

**DIP14**

**Керамический**



|  |  |
| --- | --- |
| Тип микросхемы | К555ЛА4 |
| Фирма производитель | СНГ |
| Функциональные особенности | 3 элемента 3И-НЕ |
| Uпит | 5В ± 5% |
| Uпит (низкого ур-ня) | ≤ 0,5В |
| Uпит (высокого ур-ня) | ≥ 2,7В |
| Iпотреб (низкий ур-нь Uвых) | ≤ 1,2мА |
| Iпотреб (высокий ур-нь Uвых) | ≤ 0,8мА |
| Iвых (низкого ур-ня) | ≤ |-0.36|мА |
| Iвых (высокого ур-ня) | ≤ 0,02мА |
| P | 11,8мВт |
| tзадержки | 15нСек |
| Kразвёртки | 20 |
| Корпус | DIP14 |

**К555ЛН1**

**Шесть инверторов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №выв. | Назначение | №выв. | Назначение |
| 1234567 | Вход Х1Выход Y1Вход Х2Выход Y2Вход Х3Выход Y3Общий | 891011121314 | Выход Y4Вход Х4Выход Y5Вход Х5Выход Y6Вход Х6Ucc |

1

2

13

4

6

11

5

8

10

9

3

&

&

&

&

&

12

**DIP14**

**Пластик**



|  |  |
| --- | --- |
| Тип микросхемы | К555ЛН1 |
| Фирма производитель | СНГ |
| Функциональные особенности | 6 инверторов |
| Uпит | 5В ± 5% |
| Uпит (низкого ур-ня) | ≤ 0,5В |
| Uпит (высокого ур-ня) | ≥ 2,7В |
| Iпотреб (низкий ур-нь Uвых) | ≤ 6,6мА |
| Iпотреб (высокий ур-нь Uвых) | ≤ 2,4мА |
| Iвых (низкого ур-ня) | ≤ |-0.36|мА |
| Iвых (высокого ур-ня) | ≤ 0,02мА |
| P | 23,63мВт |
| Tзадержки | ≤ 20нСек |
| Kразвёртки | 20 |
| Корпус | DIP14 |

**К555ЛН2**

**Шесть инверторов с открытым коллекторным выходом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №выв. | Назначение | №выв. | Назначение |
| 1234567 | Вход Х1Выход Y1Вход Х2Выход Y2Вход Х3Выход Y3Общий | 891011121314 | Выход Y4Вход Х4Выход Y5Вход Х5Выход Y6Вход Х6Ucc |

&

1

2

13

4

6

11

5

8

10

9

3

&

&

&

&

&

12

**DIP14**

**Пластик**



|  |  |
| --- | --- |
| Тип микросхемы | К555ЛН2 |
| Фирма производитель | СНГ |
| Функциональные особенности | 6 инверторов с открытым коллекторным выходом |
| Uпит | 5В ± 5% |
| Uпит (низкого ур-ня) | ≤ 0,5В |
| Uпит (высокого ур-ня) | ≥ 2,7В |
| Iпотреб (низкий ур-нь Uвых) | ≤ 6,6мА |
| Iпотреб (высокий ур-нь Uвых) | ≤ 2,4мА |
| Iвых (низкого ур-ня) | ≤ |-0.36|мА |
| Iвых (высокого ур-ня) | ≤ 0,02мА |
| P | 23,63мВт |
| Tзадержки | ≤ 32нСек |
| Kразвёртки | 20 |
| Корпус | DIP14 |

**ИНДИКАТОР ЦИФРОВОЙ**

**АЛС320Б**



|  |  |
| --- | --- |
| Название | АЛС320Б |
| Цвет свечения | зеленый |
| Н, мм | 5 |
| М | 1 |
| Lmin, нм | 555 |
| Lmax, нм | 565 |
| Iv, мДж | 0.15 |
| при Iпр, мА | 10 |
| Uпр max(Uпр max имп), В | 3 |
| Uобр max(Uобр max имп), В | 5 |
| Iпр max(Iпр max имп), мА | 12 |
| Iпр и max, мА | 60 |
| при tи, мс | 1 |
| при Q | 12 |
| Т,°С | -60…+70 |

**2. Расчетная часть**

**2.1. Расчет быстродействия и потребляемой мощности устройства**

* **Расчет номиналов резисторов**

Из расчетов видно, что сопротивление равно 758 Ом, а его наминал,
равен 1 кОм. Сопротивление индикатора равно 167 Ом, а его
наминал, равен 250 Ом.

* **Расчет быстродействия**

Таким образом, из расчета, время задержки составляет 127 нс.

* **Расчет мощности**

Таким образом, из расчета я получил потребляемую мощность

равную 402,88 мВт

**2.2. Расчет вероятности безотказной работы устройства и
среднего времени наработки на отказ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименее | Обозначениена схеме | Кол-воэлементов | λо10-6 | Режим работы | Усл. раб.Кλ | Коэф.а | λi =a⋅кλ⋅λо10-6 | 10-6 |
| Кн | tс |
| Резисторы | R1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1,6 | 2,7 | 4,32 | 4,32 |
| R2-8 | 7 | 0,4 | 1,728 | 12,096 |
| ИМС | DD1-DD10 | 10 | 0,1 | 1 | 50 | 1 | 2,7 | 0,27 | 2,7 |
| ИМС(К555ЛН2) | DD11-DD12 | 2 | 0,08 | 1 | 50 | 1 | 2,7 | 0,216 | 0,432 |
| Индикатор | VD | 7 | 5 | 1 | 50 | 1,6 | 2,7 | 21,6 | 151,2 |

1. Прикидочный расчет

1. Ориентировочный расчет

1. Окончательный расчет

**Графическая часть проекта.**

**Заключение.**

В курсовом проекте я разработал электрическую принципиальную схему управления семисегментного индикатора.

Изначально, по заданию, составив таблицы истинности и минимизировав логическую функцию, получили те сигналы, которые поступят непосредственно на индикатор (пройдя предварительную инверсию). Преобразовав полученные формулы и выделив повторяющиеся блоки, оптимизировал работу схемы. В ней используются микросхемы серии К555, т.к. они являются более новыми, чем серия К155, а также рассчитывались номинал резисторов, быстродействие, потребляемая мощность и вероятность безотказной работы устройства.

Значение прикидочного расчета больше, так как при его расчете было взято максимальное значение коэффициента интенсивности отказов, а в ориентировочном расчете для каждого элемента свое. Из-за этой разницы в ориентировочном расчете увеличилось P(t) и Tср.

**Список литературы.**

1. «Справочник по интегральным микросхемам» Тарабин; Москва 1981г.

2. «Цифровые интегральные микросхемы» Богданович М.И., Грель И.Н., Похоренко В.А., Шалимо В.В.; Минск, Беларусь 1991г.

3. Конспект по предмету «Конструирование ЭВМ» преподаватель – Пушницкая И.В.

4. Конспект по предмету «Типовые элементы и устройства цифровой техники» преподаватель – Золотарев И.В., Тихонов Б.Н.

5. методическая указания к выполнению курсового проекта по предмету «Электронные цифровые вычислительные машины и микропроцессоры» Пушницкая И.В., Чечурина А.В.

Ленинград 1990г.

6. Методические рекомендации по оформлению курсовых и дипломных проектов Лагутина Н.И.; Ленинград 1987г.

7. «Справочник по полупроводниковых электронных приборов» Иванов В.И.

8. «Справочник интегральных микросхем» Нефедов

9. «Импульсные и цифровые устройства» Браммер Ю.А., Пащук И.Н.